ビアプログラマブルアーキテクチャ VPEX4 の提案と性能評価 Development and Evaluation of Via Programmable Architecture VPEX4

堀 遼平十 上口 翔大十 吉川 雅弥‡ 藤野 毅† Ryohei Hori Shota Ueguchi Masaya Yoshikawa Takeshi Fujino

1. まえがき

LSI 微細プロセス技術の進歩とともに、マスクコストの 高騰が問題となっている. この問題に対して我々は"ビア プログラマブルストラクチャード ASIC"(VPSA)の利用を 検討し,これまでに3層のビアマスクで論理を変更する独自 の VPSA アーキテクチャ、VPEX3 を提案し評価してきた. 本論文では、VPEX3 の改良案として新たに VPEX4 アー キテクチャを開発した. 順序回路における消費電力の削減 と Utilization の向上による実装時面積の削減について報告 する.

2. はじめに

近年,LSI の微細化・高集積化技術の進歩とともに,製造時に用いられるフォトマスクの製造費用の高騰が問題となっている.このコスト増の影響によりLSI 開発時の Non-Recurring Engineering(NRE)コストがプロセス進歩ごとに指数関数的に増大している[1].これに伴い,小・中量生産規模の限られた市場をターゲットにした特定用途向けLSI 開発(ASIC)において,最新プロセスを用いた開発が経済的に困難になっている.

この問題に対して、小量生産品での NRE コストがほと んど不要になる FPGA (Field Programmable Gate Array) を 用いた開発が昨今注目されている. FPGA はメモリを使用 して LSI の配線経路や論理構造をチップ製造後に変更する ことが可能なデバイスであり、フォトマスク費用が不要と なる. この特性の利用によって、生産数の少ない専用回路 の開発が容易になり、特定用途向けの市場は ASIC から FPGA に置き換わりつつある. しかしその一方で、単位面 積当たりの論理の集積密度や消費電力量などの性能面では ASIC に及ばず[2]、高性能・極低消費電力デバイスが必要 なアプリケーションにおいてはすべての ASIC を置き換え るには至っていない.

これに対して、SRAM を使用せずに NRE コストを極力 おさえる LSI 製造手法として、我々の研究室では "Via-Programmable Structured ASIC (VPSA)"と呼ばれる開発手法 に注目している. VPSA は図1のようにあらかじめ作成し ておいたマスター-レイヤを一切変更せずに、カスタム-レ イヤと呼ばれる数層分のビア-レイヤのみを変更して論理 回路を実現する手法である. この手法は、大部分のフォト マスクをあらゆる開発で流用できる事、デザイン毎に必要 となるカスタム-レイヤのフォトマスクが安価で製造可能 であるビアレイヤのみであることから、LSI 開発の NRE を 大きく削減できることが期待できる. さらには FPGA と異 なり SRAM メモリを使用しないため、回路面積や消費電力

†立命館大学 理工学部/理工学研究科 :名城大学 理工部 も十分に小さく抑えることができる.

我々の研究室では"VPEX3"と呼ばれるマスター-レイ ヤのレイアウトを提唱し[3],今日までに様々な評価をして きた[4]. VPEX3 は排他的論理和ゲートをベースとした VPSA であり、1 枚のカスタムマスクだけで 22 種類のいず れかの論理を実装することが可能な Logic Element (LE) をアレイ状に多数配置することで、面積効率のよい LSI 実 装を実現している.



本論文ではこの VPEX3 の性能改善を行った. 従来の VPEX3 では配線リソース不足と順序回路における消費電 力増大の 2 つの問題を抱えており,モバイル用途で使用す る場合に大きな問題となっていた. そこでこれを改善した VPEX4 を新しく提案する.

3 章では従来手法である VPEX3 の特徴を説明する.4章 では VPEX3 の大きな問題点であり,今回改善を行った配 線 Utilization と消費電力の性能評価結果を示す.5章では 新提案である VPEX4 の構造について説明し,6章では性能 の回線に関してベンチマーク回路を使用した評価結果を示 す.7章で本論文をまとめる.

3. VPEX3 アーキテクチャ

VPEX3 は我々の研究室で提案している独自の VPSA で ある. この技術は LE アーキテクチャ,配置配線アーキテ クチャ,クロックネットワークアーキテクチャの3つから 構成される.

3.1 LE アーキテクチャ

通常の ASIC ではセルと呼ばれる論理ゲートを適切に配置することで論理回路を構成する. その一方で VPSA はあらかじめ配置された Logic Element と呼ばれる最小規模の論理回路を所望の論理素子に適切に変更することで論理回路を形成する. これは多くの FPGA の基本構造と同様の構成である. FPGA の多くが Look up-Table と呼ばれる方式を採用しているが,我々の提案する VPEX3 では排他的論理和ゲートを利用した構造になっている.

VPEX3のLE構造とレイアウトを図2に示す.VPEX3で はAOIゲートとNORゲート組み合わせた排他的論理和 (XOR)ゲートと1つのINVゲートから構成されている.第 1ビア層の有無によって,各論理ゲート間の接続を任意に 変更できる.またAOIはFlexible-AOI[3]という独自のレイ アウトになっており,OAIゲートやトランスミッションゲ ート(TG),クロックドインバータ(Clocked-INV)などに機能 を変更することが可能である.これらの組み合わせで,22 種類の論理素子機能を再現することができる.





図3は2入力 AND 論理関数を再現した際の第1ビア層 のレイアウトと LE 内部の接続状況を示したものである. AOI21 ゲートはビアパターンによって NAND ゲートに変 形することができる. NOT ゲート回路と NAND ゲート回 路を接続することで2入力 AND 論理関数を LE 内で再現す ることができる.

3.2 配置配線アーキテクチャ

VPEX3 では任意数の LE を相互接続し,組み合わせる ことで,あらゆる論理回路を実現することが可能である. そのための LE の配置,相互接続の構造として,VPEX3 ではアレイ状配置構造とメッシュ・ジャンパー配線構造を 採用している.

3.2.1 配置構造

VPEX3 では図4のような LE を等間隔に並べた配置構 造をとる. おのおのの LE は任意の論理ゲートを実現する ことが可能である. また2つの LE を組み合わせて、D-FlipFlop (DFF) を 再現することが可能である.FF の実現により、順序回路 を含む、すべての論理回路を実現することが可能になって いる.



3.2.2 配線構造

異なる領域上の LE を相互接続するには図5のような, 垂直方向に第3メタル層のトラック,水平方向に第4メタ ル層のトラックから構成された配線構造を利用する.

第3メタル層および第4メタル層のレイアウトは変更されることがなく,第2ビア層及び第3ビア層のみを実現したい論理回路に合わせて任意に変更していく.したがってメタル層のマスクコストは発生しない.配線経路の方向を変更する際はメッシュ構造と呼ばれるLE真上の領域を利用する.また配線経路を伸ばす際はジャンパー構造と呼ばれる2つのLE間におかれた小さなトラックを経由する.





ード A として選択される. これを延長させ、LE②上部の ノード Bと接続することで 2 つの LE 間の接続が実現する. 垂直方向に延長させる場合は第4メタル層のジャンパー配 線と第3メタル層のメッシュ配線を第3ビア層で接続させ ていく.また水平方向に延長させていく場合は、まず第3, 4 メタル層のメッシュ配線の交点を第3ビア層によって接 続し延長方向を変える. その後第3メタル層のジャンパー 配線と第4メタル層のメッシュ配線を第3ビア層で接続さ せていくことで水平方向の延長を実現する. この方法によ って配線層を変更することなく、ビア層のみで2つ以上の LEの接続を実現している.

3.3 クロックネットワークアーキテクチャ

順序回路を形成する際に DFF だけでなく、専用のクロッ クパスを形成する必要がある。一般的な ASIC では配置処 理後にクロックシンセシスツールを用いてクロックツリー を形成することで、クロック同期設計を達成している. し かしながら VPEX3 のメッシュ・ジャンパー構造を利用し て同様にこのクロックパスを形成した場合は以下のような 点が問題となる.

- 従来の ASIC 方式の配線よりも寄生容量が多く,動 的消費電力が大きくなる.
- 構造上, 冗長な無駄な配線を持っているため, 配 線長の均一化が困難であり、クロックスキューの バランス調整が難しくなる.
- クロックパスに大量の配線リソースを割いてしま い、ゲート間の配線が困難になる.

外部クロック 1st 2nd BUF BUF BUF BUF BUF LEのアレイ状 3th LE BUF BUF 配置領域 LE BUF : DFF BUF BUF ÷ LE LE BUF DFF BUF BUF DFF クロックピン用 配線 LE境界内の クロック専用配線 図6 クロックの経路構造

VPEX3 ではこれらの問題を回避し、クロック同期設計 を実現するために「クロックネットワーク」を予め LE ア レイ周囲に構成している.

図 6 は VPEX3 のクロックネットワーク構造を示したも のである. 論理実装領域の周囲には3種類のバッファセル を配置している. ソースとなるクロックパルスを受け取り 両サイドに伝播させるための「first-buffer」が1つ,論理 領域の両側部の上部から下部まで伝播させるための 「second-buffer」が2つ、各列から内部の DFF にクロック パルスを伝える「third-buffer」が LE 行数個分だけ用意さ れている. この3段のバッファを用いてスキュー差が 500ps に抑えることが可能なクロックネットワークを形成 している.

4. 現行手法 (VPEX3) の問題点

VPEX3 プラットフォーム上で実装した論理回路の性能 を評価するために、専用の CAD システムを開発した[5]. この CAD システムでは論理合成後のネットリストに対し て配置、配線処理を自動化し、ネットリストと整合の取れ た LSI レイアウトのデータを GDSII フォーマットで出力す る. この CAD システムを利用して,実際に DES 暗号化回 路を設計・製造し[6]、実チップを用いて評価を行った. そ の結果、次に述べる2つの問題点がわかった.

4.1 配線混雑による低 LE 使用率の問題

VPEX3 には1LE あたり X 軸方向に 8本, Y 軸方向時 8 本の配線リソースが存在する.しかし配線最適化を行うに 当たって、この本数では配線リソースが少なく、空論理の LE を配置し、その配線リソースを使用しなければすべて のノード間接続が行えないことが明らかになった.再現可 能な論理のいずれかが実装された LE を「有効論理 LE」と 定義し、実装に用いたすべての LE における、有効論理 LE の比率を「LE 使用率」と定義する. すべてのノード間接 続が可能になった時の LE 使用率の見積もりを複数のベン チマーク回路ごとに実験し、見積もりを行った. ベンチマ ーク回路には ISCAS' 89[7]の一部を使用した. 結果を以下 に示す.

衣 1 谷	谷へンナマーク回路における配線成功率			
回路名	s9234	s13207	s15850	s38584
LE 使用率	52.4%	25.4%	33.2%	29.8%

この結果より、VPEX3 プラットフォーム上に論理回路 を実装するとき, s9234 では半分以上の領域, 他の回路も 全体の約 70%の領域は配線のための空論理 LE で占められ ることになる. 同様の結果が DES 暗号回路設計時にも観 測され、そのときの LE 使用率は約 44.32% であった. した がって VPEX3 の1 LE あたりの配線リソース数はこの規模 の回路の実装においては不足しているとわかる.

4.2 消費電力の問題

実チップを使用した消費電力の測定を行った.測定にお いては、初めに3つの状態で調査を行った.

- 電力供給のみを行い,回路を動作させない場合
- 電源供給に加え、クロックネットワークにクロッ ク信号を供給した場合

上記に加え、入力にテストパターンを供給し、実際に動作させた場合

これらのデータをもとに,実チップにおける消費電力の 分布を「静的消費電力」「クロックツリー部の動的消費電 力」「実回路部の動的消費電力」として分類した.これら をまとめたものを図7に示す.

測定結果より,クロック供給時の消費電力が全体の 60% 以上を占めている事が判明した.VPEX 3 のクロックネッ トワーク構造では合計 203 個のバッファセルを使用してい る.これらのセルの貫通電流電力,および充放電電力が ASIC と比較して非常に大きいことが明らかとなった.



5. VPEX4の提案

前章で述べた問題点に対して、それぞれ改良を行った. 本章では改良案とその効果について述べる

5.1 LE 構造の改良

配線混雑度の観点より, 1LE あたりの縦横 8 本の配線 リソースは最適ではないことがわかった. そこで LE のサ イズ変更および1LE あたりの配線リソースの増量を行っ た.

図 8 が新たに提案する VPEX4 の LE アーキテクチャであ る.まず VPEX4 では LE の縦長および横長が 6.0µm から 8.4µm に変更し、1 LE あたりの配線リソース数を 8 本から 12 本に増やしている.

またこれに伴い拡大した分だけ、より多くゲートを置く ことができるようになったため、LE 構造の改良も行った. まず INV ゲート素子を2つに増やした.これにより否定論 理をあと1つ必要としていた3入力 AND や3入力 OR 回 路を再現する事が可能となった.次に AOI ゲート素子を3 入力論理ゲートから4入力論理ゲートに変更した.これに よって4入力の AOI 論理に加え、図9のようにビアを利用 して接続経路を変更する事で、4入力の OAI 回路も再現で きるようになった.

この 2 つの改変によって,再現可能な論理ゲートの種類 が従来の 22 種類から 30 種類に大きく拡張された(図 10). これによって,論理合成時に選択できる論理セルが増加し たため,論理合成後の LE 総数の削減が期待できる.









図 10 VPEX4 で再現可能な論理セル

5.2 クロックネットワーク構造の改良

従来のクロックツリーでは図 11(a)のように DFF の入力 付加容量が非常に大きく,そのためクロックツリーには非 常に大きなドライブ能力を持つバッファを利用していた.

そこで新アーキテクチャでは DFF 構造の改良を施し,入 力付加容量を従来の 1/3 程度に削減した.これによりクロ ックツリーを構成するバッファサイズを非常に小さく,ま た数自体も少なくすることが可能になった.

新しい DFF 構造の回路図を図 11(b)に示す. DFF のクロ ックピンにインバータセルを介す事で,クロックツリーの バッファから見える入力負荷容量を削減している.



また DFF 再現時のドライブ能力も改善された. 従来の DFF は出力素子 Q のドライブ能力は NOR ゲートのドライ ブ能力に依存していた. しかし VPEX4 の DFF では,出力 側を INV でドライブするように変更した.

これらの DFF の改変によって新たに構成したクロックツ リーを図 12 に示す. VPEX4 のクロックツリーではバッフ ァのドライブ能力の調整を行い, VPEX3 のものよりも小 さいものに変更している. また VPEX3 では両側部の列に バッファを配置していたが, VPEX4 では片側だけに削減 する事ができた.



図 12 クロックネットワーク構造

6. 性能評価

6.1 DFF の単体特性評価

改良した DFF の性能評価を行った.評価項目は遷移遅延, 消費電力の 2 項目で,比較対象は VPEX3 と VDEC から提 供されている 0.18um プロセス用のスタンダードセルの DFF を使用した. 図 11 および表2に「立ち上がり」,および「立ち下が り」の遷移遅延を示す.これらの結果より,立ち上がり, 立下り両方の性能において,従来のDFFよりも大きく改善 されていることがわかる.これは DFF の出力端子に INV を接続したことによって,ドライブ能力が大きく改善され たためだと考えられる.



図13 DFFの遷移遅延の性能評価結果

表 2 DFF の遅延時間				
	立ち上がり遅延[ns]	立ち下がり遅延[ns]		
ASIC	1.12	0.55		
VPEX3	2.31	1.32		
VPEX4	1.20	1.01		

次に消費電力の比較結果を示す. DFF の消費電力は Cadence 社の SPICE シミュレータ「Spectre」を使用した. 結果を図 14 に示す.



図 14 DFF の消費電力評価結果

結果より,各出力負荷容量において VPEX3 よりも VPEX4 の消費電力の方が非常に大きくなっており,性能 が悪くなっていることがわかる.これは VPEX4 の DFF の 方が構成により多くの論理ゲートを使用しており,そのた めインターナルパワーが大きくなっているためだと考えら れる.

6.2 配線混雑度と実装面積の比較

実装面積の比較を行う.対象のベンチマーク論理回路は 共通鍵暗号化方式の一種である「DES」「AES」を用いた. 以下に結果を示す.



測定結果より, 配線リソースを増やしたことによって LE 使用率が大きく改善された. 従来の VPEX3 アーキテク チャは 70%を配線のためのリソースに割く必要があったが, VPEX4 ではこれが改善され, 空論理セルを大幅に削減で きている. それによって大幅に面積性能が向上した. 実際 に ASIC と比較すると, 2 倍程度の面積増加で VPEX4 プラ ットフォーム上に同等の回路を形成できている.

6.3 消費電力比較

消費電力の比較を行う.対象のベンチマーク回路は前節 同様「DES」「AES」の2つの論理回路を用いた.結果を 以下に示す.



図16 消費電力の比較

上記の結果より、クロックツリーの消費電力は大幅に削減できたことがわかる.しかしその一方で、論理回路自体の消費電力は非常に大きくなっていることがわかる.これは 5.1 節で述べた VPEX4 の DFF の消費電力が大きくなったことに起因すると考えられる.

消費電力の合計値を比較すると,論理回路部の消費電力 の増加分よりもクロックネットワーク部の消費電力削減分 のほうが大きく,全体では消費電力の削減に成功している ことがわかる.しかしながら,より多くのDFFを使用する 論理回路(例えば大規模なカウンタや CISP などのプロセ ッサ)では VPEX4 の消費電力がより大きくなることが懸 念される.

7. まとめ

本論文では既存の VPSA アーキテクチャである VPEX 3 の課題点を明らかにし、それらを改善した新アーキテクチャとして VPEX4を提案した.従来の LE よりも面積が大きい構造であるものの配線リソースに余裕のある構成になっている.

実際に改善されたことを証明するために、3つの性能評価を行った.1つ目はDFFの比較を行った.これにより、 ドライブ能力が改善されたことを示した.2つ目は実装時の面積比較をおこなった.LE1つあたりの配線リソースが 改善されたことにより、実装領域上の空論理セルが減少し、 面積が大きく削減されたことを示した.3つ目は消費電力 の評価を行った.領域を論理実装部とクロックネットワーク部で分けて評価を行ったところ、論理実装部では消費電力が増大していたが、クロックツリーの消費電力は改善されており、結果として消費電力をDESにおいては約53%、 AESにおいては17%削減することに成功した.

今後の課題点としては、デジタル回路以外の CMOS 電子 回路(たとえばアナログ回路)に VPSA 技術を適応し、 VPSA 技術によって実現できる回路デザインの幅を拡大し ていくことがあげられる.

8. 謝辞

本研究は東京大学大規模システム設計教育研究センター を通し、ローム(株)の協力で行われたものである.関係各 位に感謝いたします.

文 献

[1] I M. Ladepus, "Analysis: Photomask Business Model is Broken", EETimes,

http://www.eetimes.eu/germany/211200004?pgno=1

- [2] I.Kuon and J.rose "Measuring the Gap between FPGAs and ASICs" IEEE Trans. Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol.26 No.2, 2007 p.203.
- [3] Ryohei Hori, Tatsuya Kitamori, Taisuke Ueoka, Masaya Yoshikawa, Takeshi Fujino,"Improved Via-Programmable Structured ASIC VPEX3 and its Evaluation", IEICE Trans. on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer, Vol.E95-A, No.9, pp.1518-1528, Sep. 2012.
- [4] 大谷拓,堀遼平,上岡泰輔,吉川雅弥,藤野毅, "ビアプログラマブルロジック VPEX の配置配線ツ ールを用いた性能評価",電子情報通信学会技術研 究報告, VLD2012-90, pp.177-182, 11月 2012 年
- [5] Ryohei Hori, Taisuke Ueoka, Taku Otani, Masaya Yoshikawa, Takeshi Fujino,"Via Programmable Structured ASIC Architecture "VPEX3" and CAD Design System", IEICE Trans. on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer, Vol.E95-A, No.12, pp.2182-2190, Dec. 2012
- [6] Ryohei Hori, Taisuke Ueoka, Taku Otani, Masaya Yoshikawa, Takeshi Fujino,"The implementation of DES circuit on via-programmable structured ASIC architecture VPEX3", 2013 International Symposium on VLSI Design, Automation, and Test (VLSI-DAT2013), April 2013
- [7] F.Brglez, D.Bryan, K.Kozminski, "Combinational profiles of sequential benchmark circuits," Proceedings of ISCAS, pp.1929-1934, 1989.